

铌酸锂直波导相位调制器

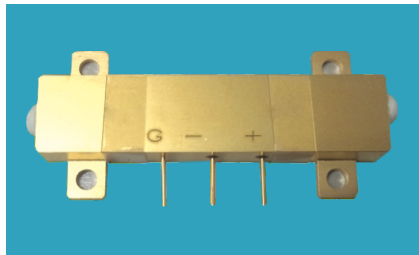
产品描述

铌酸锂直波导相位调制器采用钛扩散或质子交换工艺制备,具有插入损耗低、驱动电压低的特点。该产品通过了GR-1221-CORE可靠性试验以及各种环境考核试验,产品性能稳定,可靠性高,已在国家多个重点工程中应用。

产品特点

- 低插入损耗
- 小体积
- 低驱动电压
- 长寿命、高可靠性

产品图片



产品应用

- 光纤传感领域
- 相干光通讯领域
- 量子保密通讯领域

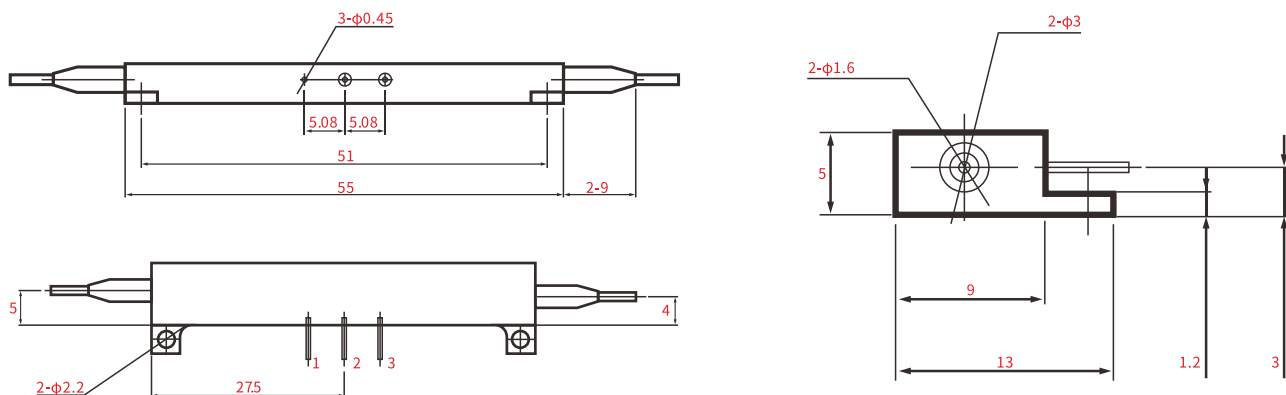
常温技术指标

参数	单位	技术指标
工作波长	nm	1310(±20)
插入损耗	dB	≤3.5
偏振相关损耗	dB	≤1.0
尾纤偏振串音	dB	≤-27
输入光功率	mW	≤50.0
光回波损耗	dB	≥45.0
残余强度调制	/	≤2.0‰
半波电压(@1KHz, TE)	V	≤3.5
波形斜度	/	≤1/200
最大施加电压	V	≤15.0
带宽	MHz	≥50
电接口	/	3引针
尾纤	/	单模或保偏光纤
工作温度范围	°C	-40 ~ +85
贮存温度范围	°C	-55 ~ +85

全温技术指标

参数	单位	技术指标
温度范围	°C	-40 ~ +85
插入损耗变化量	dBm	≤0.5
尾纤偏振串音	dBm	≤250

封装尺寸



定制信息

- 可根据客户的需要, 定制不同的技术指标
- 可按客户要求定制不同尺寸的封装管壳形式